

・トランジスタ基板のドライン電極パッド及びエレクトロードミネセンス体のうちの少なくとも一方に該部位付近
接地面を配置する工部、トランジスタ基板のドライン電極
パッド及びエレクトロードミネセンス体のうちの少なく
とも一方に該部位付近接地面を配置する工部、並びにドライン電極
外端部となる部位に配置する工部、並びにドライン電極
パッドとエレクトロードミネセンス体との間隔は、
に、前記トランジスタ基板とエレクトロードミネセンス体のうちの少なくとも一方に該部位付近接地面を配置する工部
基板と並行配置し、重ねさせる工部を行なうことを特
徴とするエレクトロードミネセンス体の製造法。
【請求項30】 前段の実施例に於て記載した特許
トランジスタ、行間に、並行上の複数の構成トランジッ
クのゲートを並列に接続したゲート線、列間に、該構成上
の複数の構成トランジックのソースを並列に接続したソ
ース線、構成トランジックの各ドライン間に接続したド
ライン電極パッド、及び導線ドライン電極パッドに接続し
たコンデンサを備えたトランジック基板を用意する工
程、該電極の配線に沿って設けたエレクトロードミネセンス体を
備えたエレクトロードミネセンス基板を用意する工部、
トランジック基板のドライン電極パッド及びエレクトロード
・ミネセンス体のうちの少なくとも一基に複数個並列
接地面を配置する工部、トランジック基板のドライン電
極パッド及びエレクトロードミネセンス体のうちの少なく
とも一基に複数個並列接地面を配置する工部、並びに構成ト
外端部となる部位に配置する工部、ドライン電極パッドと
ヒエレクトロードミネセンス体との間隔は、前記トラン
ジック基板とエレクトロードミネセンス基板との間を該接
面間隔及び、重ねさせる工部、並びに構成トランジック基
板とエレクトロードミネセンス基板との間を該接地面間隔
を加熱融解して、接合する工部を行なうことを特徴とす
る工部を行なうことを特徴とするエレクトロードミ
ニセンス体の製造法。

レクトロ・ルミネセンス要素、各第3端子間に接続したコンデンサ、エレクトロ・ルミネセンス要素の一側の導線と第1スイッチング端子の第3端子間に接続した

第1スイッチング装置をオフとするための第2オブジェクトをハリスを監視装置に附加し、該第2オブジェクトがハリスを監視する。その前で、又はその後第2スイッチング装置をオフにするための第3オブジェクトを第3スイッチング装置の監視装置に附加し、これによつて、該監視装置と

加（一フレーム間隔は一フレーム間隔の1/4、3/4の割合、好みは1/3～2/3の割合、4/3は、約1/2の割合である）
【01-6】本規則で用いた縦バスクロントと並ば
スクロントの横並半端則は、専門に規定されているの
ましい。
[01-7]

起されることなく、アモルファシリコンや高分子シリコン等の導電性高分子を用いたスターガーランド又はゴムフレーク状の何れも適用することが可能である。本実験では、結晶シリコンを用いたSOS(シリコン・オン・インシングレーク)構造のMOSトランジスターに適用することができる。
100271) コンデンサC₁は、図4の一般のコンデンサ構成と同様に、2枚の導電性高分子のコンデンサチャップ間に設けたSiO₂膜33によって形成される。コンデンサチャップ

を印刷し、専用の第1版輪に第1スイッチング部 β をオフとするため第1オフ信号バルスを印加し、第1オンバルスに同期させて第2版輪に情報に応じた第1バイアスの状態でバルスを印加し、専用抵抗 R_1 のための第2

手段を作成せざる結果手段を行つてエレクトロ・ルミネセンス装置に、第17の特徴をし、第18に、複数の行及び列に沿つて配列したスイッチング網子、行層に、行層の端のスイッチング網子の端部が網子に接觸する。

第1組合、別途第1の組合、前述の組合、すなはち、スイッチング網子を、別途第1の組合、前述の組合、すなはち、スイッチング網子の端部が網子に接觸する。

（完刊の実況の説明）本刊例を西側に沿って説明する。以下、上記模様トランジスタを「TFT1」と記し、上記エレクトロ・リミニセンス体を「REL1」と記述する。
S10181回は複数マトリックス4端子TFT-E
1.素子の構成を示す。各画素の累積は2つのTFTと
並列コンデンサから成る。4端子が次のTFTな
特徴はE1-T TFT構成から来るアドバンス日月を分離す
る能力である。E1-素子は複数TFT（T1）を介して
サブ構41と4.2及び4.3の一コンデンサ電極間に接続
され、TFT2のドレインに接続される。
S10181ゲート-3端子-スペア2.4は、ク
ロム/アルミニウム配線が軽く剥り切れる。
【029】バッジーション3-4としては、グラスマ

特徴はE.L.端子部からのアドレスイング信号を分離する能力である。E.L.端子は通常TFT (T1) を介して選択され、EL.素子に対する駆動信号は通常TFT (T2) により翻訳される。記憶コンデンサはそれがいったん選択されたアドレスされたE.L.素子に駆動能力を留めることを可能にする。原くして回路はE.L.端子がアレッジングに対して弱り当たる初期を濫用して100 ロム/アルミ複合配線が軽く用いられる。
[0029] バンベーション3-4としては、ソラズマCVDによってチップシリコン膜が焼いている。
[0030] ドレイン電極バット2.2としては、反射性金属をせらるために、アルミニウム、銀などの金属膜を用いることができるが、ITOやZnOの様な透明導電膜であつてもよい。

用可能、その外で、又はその後で電子スイッチ等をオンとするための約3オン13OFFバルスを約3スイッチング粒子の解離に用出し、これによつて、電流が約3倍とエレクトロ-ルミネセンス強度の増加との関

に、エレクトロ・ミネセンスによって電離する際に、常に吸引される電離ガスを、
離して生じさせる構造物のバルスを、**反応性バルス**と印加
し、前述説明された行に於ける各電極への次の走査
運動操作又は、その後の走査運動計の開始の瞬間に
で、エレクトロ・ミネセンス体に対して逆アライズ状態

ミネセンス技術に、第6の特徴を行し、第7に、複数の行及び列に沿って配列した第1複数トランジスター、行方向に、行上の複数の第1複数トランジスターのケートを並置して構成した第1配列、列方向に、列上の複数の第1複数トランジスター

度を生じさせながらバイパス走行。第3回配達を通して、放電エレクトロ・ルミネセンス体に作用する酸素投与を行なうエレクトロ・ルミネセンス装置に、第4回の作業を行なうる。

レース走行用タイヤ・インターレース走行の例であつてもよい。
100201 ソース・ラインX、Xm、Xmは、
前輪は840本、1280本などの間に多段変速範
囲、ゲートノットと同期させて、駆動データに応じて
選択した時に相応の駆動比率が自動的に選択される。
〔0021〕車中のRELは車輪駆動REL、CELは輪
形駆動REL、BELは全車駆動RELで、ソースラインX
前面を形成するアルミニウムなどのREL、車輪駆動REL 6.2 及
び車輪駆動RELによって構成される。
〔0033〕EL 5.2としては、駆動RELが構成され、
REL、GELとRELを構成するものが組合せ、
れる。
〔0034〕具体的にREL、GELとRELを下記
に示すが、本明細はこれらに範囲されるものではな
く、また何種ELの内特に黒色ELを適用することも

翌朝、技ドレインと進エレクトロ・ルミネセンス技術の
データを元に設計され、データアクリルを導入して

子を接着剤中に分離させて、特にシランカップリング剤を含行させたものが好ましい。

X₁, X₂ には赤色の消色性のアルズ、X₃ には緑色の消色性のアルズ、X₄ には青色の消色性のアルズである。これによつてフルカラー表示が行なわれる。
100221 図2は、本発明のTFT基板3の代表例を示す半導体素子である。TFT1は基板3のT₁に形成し、T₂ は基板3のT₂ に形成する。
〔0035〕本発明の有機ELでの構成、SconzellavaのEP-A-3,49,265(1990); Takemotoのアメリカ特許第4,356,429号; Van Slyckのアメリカ特許第4,539,507号; Vykopalのアメリカ特許第4,539,507号; Vykopalの米国特許第5,000,439号。

チック系ド、エレクトロ・ルミネンスン系の一方の音に接続した第3配線、或第3配線中に設けた第2スイ

【0012】耐候性トランシスクは、ポリシリコン半導体又はアモルファシリコン半導体を用いるのが好ましい。
【0013】耐候エレクトロ・ルミネンス体をaska

Cに付属し、ドライヤー用排水パイプを接続する。また、本装置は、
460Tのドレン接続部に対応している。

100231 図16、図12のA-A断面図である。図
上は、図12のB-B断面図である。

[0024] 本発明で用いた TFT TFT TFT 2とし
2,Taniguchi等による特許第4,769,292
号; Taniguchi等による特許第4,885,211
号; Perry等による特許第4,950,95
0; Littmann等による特許第5,059,84
6号; Van Slyck等による特許第5,04

バルスに何機させて第2配線に情報に応じた耐バイアスの階級別にバルスを印加し、論及所定行のための第1・2

[0014]本発明の第6、第7及び第8の実施によれば、アクティーマトリクス駆動において、エレクトロ・ルミネセンス要素に交流電圧を印加することを可能とし、これによって、特に、有機エレクトロ・ルミネセンス

第1ステッピング操作の繰り返しに応じて回転角が増加し、これによって、航行上の各エレクトロ・ルミネンスス体への射込みを推動させ、そして、被照光周波数

フェノール系熱可塑性樹脂にカーボン粒子、銀粒子や
銅粒子の導電性樹脂が充合された導電性樹脂樹脂
を用い、これをスクリーン印刷法、オフセット印刷法又
はディスベンサー塗装法などの方法によって、EL基板
上またはTFT基板上、あるいはその両方の所定位置に
塗布し、乾燥させることによって得られる。

(0056) 上述の導電性樹脂樹脂には、光照射力を
抑制するために、N-(2-アミノエチル)-3-アミ
ノプロピルメチルジメトキシジラン、N-(2-アミノ
エチル)-3-アミノプロピルメトキシジラン、3-ア
ミノ-1-プロピルトリメトキシジラン、3-ア
ミノメチルトリメトキシジラン、3-グリシンジメトキ
シランなどのシランカップリング剤を含
むことができる。

(0057) 指示部遮蔽樹脂7の遮蔽物としては、
ハニカムなどが挙げられる。

(0058) 上述の遮蔽部遮蔽樹脂7の外周部に
は、接続部遮蔽樹脂7が接着される。接続部遮蔽
樹脂7は、エポキシ系又はフェノール系熱可塑性樹脂
又はTFT基板6またはTFT基板、あるいはその両方の所定
位置に、オフセット印刷法、スクリーン印刷法又は
スパンサー塗装法などの方法によって、塗布し、乾燥
せることによって得られる。この際、接続部遮蔽樹
脂7は前記の塗布によって、EL基板6またはTFT基
板の一方の端部に対して塗抹接觸面を設け、この端部
塗抹面を露けていない方の塗抹面において初期遮蔽性質を
成ける塗抹接觸面を用いるのが好適である。

(0059) また、本発明では、上述の遮蔽部遮蔽樹脂
7又は接続部遮蔽樹脂7が接着部遮蔽樹脂7と接着する
有機樹脂、特に高分子量樹脂やネマチック樹脂、コレ
ステリック樹脂、スマートチック樹脂の導電性樹脂などの液
体導電性樹脂を用いることもできる。

(0060) また、上述の接続部遮蔽樹脂7とTFT基
板接觸部遮蔽樹脂7とは、遮光部遮蔽樹脂7と被せつけられ、若
干色調や形状などの外見性質を合わせさせることもできる。

(0061) 本発明のEL素子の製造に当って、TFT
基板6のドライバ部パッド2-2の上に導電性樹脂樹脂を
噴露する際に、オフセット印刷法を用いて塗布し、EL基板6の
側面部に導電性樹脂樹脂を付着させた導電性樹脂のシッキン
グアーティクルスを接着部遮蔽樹脂7と導電性樹脂のシッキン
グアーティクルスの間に介して、両方に付せた導電性樹
脂7-1と導電性樹脂樹脂との間に接続する。

EL基板6-2以外の領域(EL基板6-2の外
周部)に導電性樹脂樹脂を付着させた導電性樹脂を用い
て塗布し、ドライバ部パッド2-2とEL基板パッド6
2と導電性樹脂7の間に接続する。これによって、EL基板6の
TFT部、水平アーティスト基板3とEL基板6との間隔の
空気を通じて供給され、EL基板3と6とに付せた導
電性樹脂7を介し、導電性樹脂7と導電性樹脂7との間に
接続を行なうが、導電性樹脂7とEL基板6との間に
重ね合せた状態で、ステージ8-1の上に塗布し、既に
に電極固定された一対のリング8-2と8-3との間にブ

ラスチックフィルムなどのシート8-3によって、図示の
如く覆い、かかる後に初期導電ボンツ8-4を形成させ、
シート8-3内の空気を除去する。

(0063) 以上は、本発明の例のEL素子の導電性樹
脂7-1の空気を除去する。

(0064) [図10及び11]は、本発明の第6、第7段
工程8の導電性樹脂7に対する遮蔽物である。

(0065) [図11] G₁, G₂, ...G_n (n本の)ゲート遮蔽物
は、網版トランシスタで構成したシリコンゲートTR
のゲートに接続したゲートオノンバルス(G₁)である。
オノンバルスの導電性樹脂7によって、印込み行の遮蔽がな
れる。この遮蔽部遮蔽樹脂7となるゲートオノンバルスG₁,
(n-1)G₂, ...,G_n、インターレース遮蔽方式による構成であ
つてもよく、ノンインターレース遮蔽方式による構成
であってよい。また、インターレース遮蔽方式による
遮蔽のときには、1本隠し、又は2本以上の隠しに
よるインターレース遮蔽であってよい。

(0066) S₁, S₂, ...S_m, ELの遮蔽樹脂を
構成するための網版トリニティスであり、所定発光部側に、
網版トランシスタで構成したシリコンゲートTRの
ゲートに印加され、G₁, G₂, ...G_nのゲートオノンバル
スハイ・レベル側の印加側、又はその前で、又は
その後で、印加され、この時ELは、駆動バイアス状態
に置きされる。

(0067) S₁, S₂, ...S_m, ELの発光を遮
させ、その代わりに、パラフィン樹脂RB, RBB...P
BからELに対して駆動バイアスを印加するためには、ス
イッチングゲートTRへのゲートオノンバルス(ロー・レ
ベル側)の印加側、又はその前で、駆
動トランシスタで構成したシリコンゲートTRのゲ
ートに対して、ゲートオノンバルス(ハイ・レベル側)
として印加される。

(0068) [図11]本発明のEL素子の導電性樹脂7における
EL遮蔽の遮蔽面である。

[図6] [図10]C-C'遮蔽面である。

[図7] 本発明のEL素子の導電性樹脂7である。

[図8] 本発明のEL素子で用いたEL基板側における
EL遮蔽の遮蔽面である。

[図9] 本発明のEL素子で用いたEL基板側における
EL遮蔽の遮蔽面である。

[図10] 本発明のEL素子の導電性樹脂7である。

[図11] 本発明のEL素子の導電性樹脂7である。

[図12] 本発明のEL素子の導電性樹脂7である。

[図13] 本発明のEL素子の導電性樹脂7である。

および、各JLには、交差部Eが形成され、遮電部E
が露出して光発光できた。

[0071] 本発明は、先述技術に適用するが如
く、電子写真プリンタ用導電性樹脂として用い
ているが、電子写真プリンタ用導電性樹脂として用い
られているレーザ技術又はLED技術や液晶バックア
レイ技術(液体水晶技術)にてして、操作すること
もできる。

[0072] [別表の発明] 本発明によれば、高品質で、かつ高精度
で、長寿命のEL表面を大面积に亘って、高い生産性を
もって得ることができた。

[0073] また、本発明によれば、高精度のEL发光
を有することができ、高精度で、高精度でしかも高効率
な駆動技術のELカラーディスプレイを高い性能にて
得て、EL素子を得ることができた。

[0074] さらに、本発明によれば、新規に対する安
定性、長期的耐用期間における表示安定性を実現したEL
カラーディスプレイを構成することができた。

[別表の発明] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0075] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0076] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0077] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0078] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0079] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0080] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0081] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0082] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0083] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0084] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0085] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0086] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0087] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0088] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0089] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0090] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0091] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0092] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0093] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0094] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0095] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0096] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0097] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0098] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

[0099] 本発明のEL素子の導電性樹脂7における
カラーディスプレイを構成することができた。

である。

[0012] 本発明で用いたEL基板の半導体である。

[別表の発明]

T1 第1網版トランジスタ

T2 第2網版トランジスタ

C8 コンデンサ

REL 電極電極

GEL 駆動電極

BEL 画像電極

21 コンデンサ

22 ドライビングヘッド

23 ゲートバッ

24 ソースバッ

25 グランドバッ

3 TFT基板

31 ガラス基板

32 PECVD

33 SiON膜

34 パンチーション膜

41, 42 コンデンサ地線

5 EL基板

5, 51, 511, 512, 51n 遮電部

52 EL

6, 1 ガラス基板

6, 2 EL駆動バッ

7, 1 駆動電極遮電部

7, 2 接続部遮電部

8, 1 ステージ

8, 2, 8, 3 O-リング

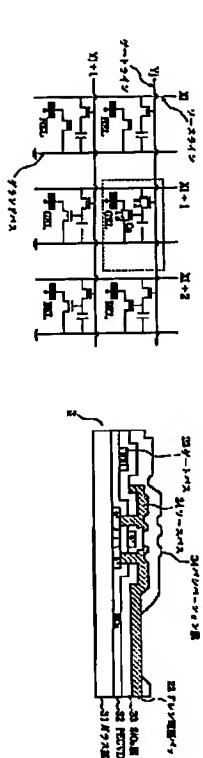
8, 3 シート

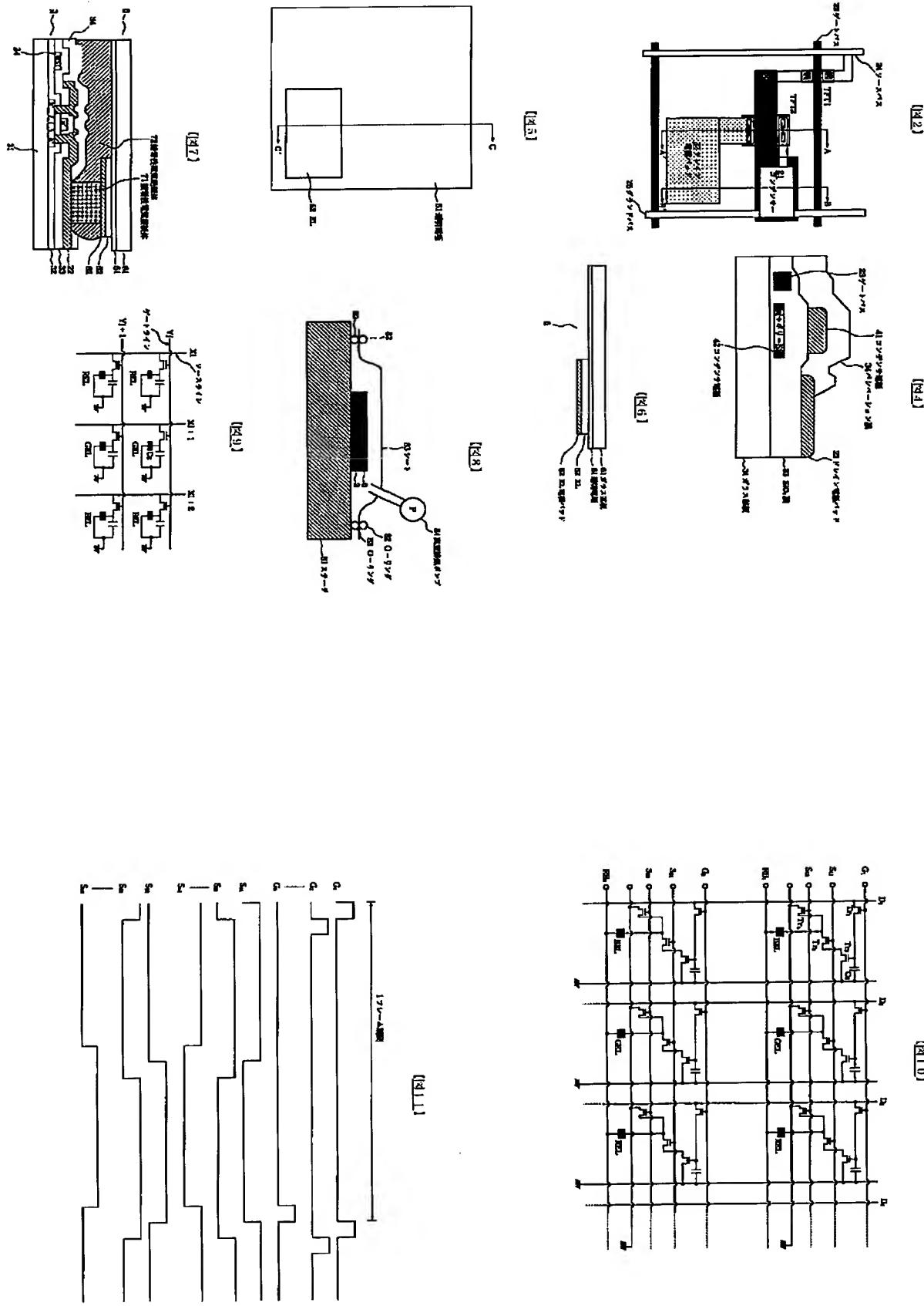
8, 4 駆動部ボン

12, 1 ゲートアレイ

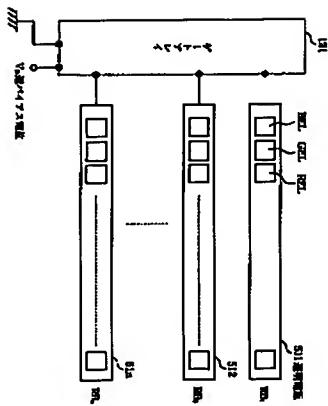
RBL, RBB, ...PB, バイアス駆動

Vt 逆バイアス駆動





[図13]



フロントページの動き

(72) 登記者 棚本 雄一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社内

(72) 登記者 姫川 稔

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャノン株式会社内